

УДК 537.311.32 : 539.143.43

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ЯМР СТРОЕНИЯ И ИОННОГО ТРАНСПОРТА

В ДИАМАГНИТНЫХ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ $M_{1-x}R_xF_{2+x}$

*A. Н. Мацулев, В. М. Бузник, А. И. Лившиц,
П. П. Федоров, Б. П. Соболев*

Методом непрерывного ЯМР ^{19}F на частоте 48 МГц исследованы монокристаллические образцы твердых электролитов $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ и $\text{Ba}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{F}_{2.25}$, относящихся к диамагнитным флюоритоподобным твердым растворам. Сопоставление теоретических расчетов и экспериментальных данных позволило осуществить привязку компонент спектров к двум структурным позициям — основной решеточной F_p и междуузельной F_m . Предложен метод и сделана оценка заселенности структурных позиций на основе ориентационных зависимостей второго момента спектров. Изменение формы и дисперсии спектров при нагревании является характерным для образцов с диффузионным движением ионов. Анализ экспериментальных данных позволил установить, что анионные системы твердых растворов динамически неоднородны. При температурах 290—470 К в ионную проводимость вносят вклады ионы обоих типов фтора (F_p и F_m). В этом интервале температур частоты движения значительной доли ионов фтора превосходят 10^4 Гц. Измерения, проведенные на $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$, показали, что ионы фтора в междоузельных позициях более подвижны, чем в решеточных.

Интерес, проявляемый к флюоритоподобным твердым растворам $(1-x)\text{MF}_2-x\text{RF}_3$ (M, R — соответственно щелочноземельный и редкоземельный металлы), определяется их оптическими и электрическими свойствами как фторпроводящих суперионных проводников. Вариация состава твердых растворов, сохраняя структурный мотив, позволяет расширить круг фторидов, важных в практическом отношении, а также управлять физическими свойствами этих материалов. Процессы ионного переноса во флюоритоподобных твердых растворах во многом зависят от особенностей структурного строения, которые в свою очередь определяются ионными радиусами двух- и трехвалентных катионов, а также концентрацией трифторида [1, 2].

Экспериментальные исследования кристаллического строения твердых растворов сталкиваются с затруднениями, особенно в системах со значительной нестехиометрией состава. Этим отчасти объясняется большое количество структурных моделей твердых растворов и механизмов ионного транспорта во флюоритоподобных электролитах. В свете сказанного будут полезными исследования микроскопического строения твердых растворов $M_{1-x}R_xF_{2+x}$ методом стационарного ЯМР ^{19}F , зарекомендовавшего себя эффективным экспериментальным методом в изучении монокристаллических растворов, содержащих магнитные редкоземельные катионы R^{3+} .

В настоящей работе проводятся исследования структурного строения и транспортных процессов методом стационарного ЯМР ^{19}F в монокристаллических образцах $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ и $\text{Ba}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{F}_{2.25}$, в дальнейшем обозначенных 1 и 2 соответственно. Помимо этого, необходимо выявить возможности метода в изучении диамагнитных твердых растворов $M_{1-x}R_xF_{2+x}$, поскольку с точки зрения ЯМР они имеют принципиальные отличия от изученных ранее парамагнитных структурных аналогов [3] в силу отсут-

ствия сверхтонких полей на ядрах ^{19}F . По имеющимся представлениям (см., например, [1]) в зависимости от соотношения ионных радиусов основных и примесных катионов, а также концентрации в твердых растворах образуются разного типа дефекты. По этому признаку $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ и $\text{Ba}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ относятся к разным типам твердых растворов.

1. Методика эксперимента и синтеза образцов

Выращивание монокристаллов $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ и $\text{Ba}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ проводилось методом Бриджмена—Стокбаргера из расплава в графитовых тиглях в атмосфере гелия высокой чистоты с использованием фторида

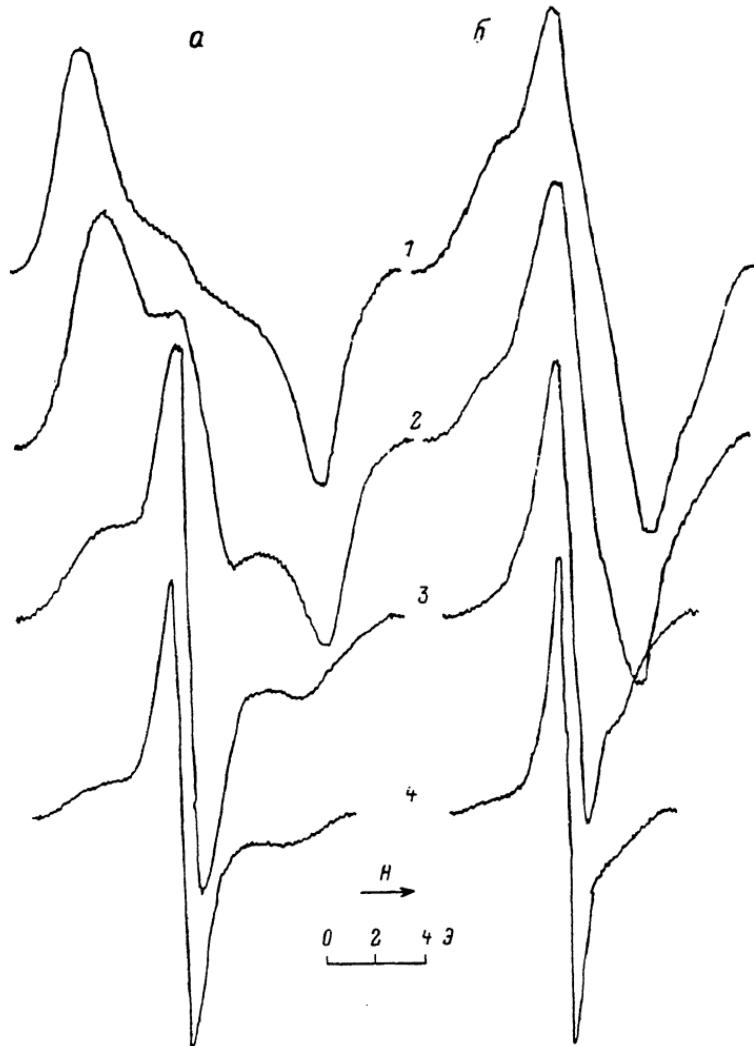


Рис. 1. Температурная зависимость формы спектров ЯМР ^{19}F монокристалла $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$.

a — внешнее поле H_0 ориентировано параллельно оси $\langle 100 \rangle$ кристалла, *b* — параллельно оси $\langle 111 \rangle$.
1 — 291, 2 — 344, 3 — 383, 4 — 403 К.

свинца в качестве «раскислителя» для очистки от примеси кислорода. В качестве исходных веществ использовали SrF_2 и BaF_2 марки «ОСЧ» и LaF_3 , YF_3 марки «ХЧ», предварительно проплавленные во фторирующей атмосфере продуктов пиролиза тефлона.

Запись спектров осуществлялась на спектрометре JNM-3H-60 на частоте 48 МГц, в температурном интервале 290—470 К. Измерение химических сдвигов проводилось относительно сигнала жидкого эталона CCl_3F .

Ориентация образцов осуществлялась на рентгеновском гониометре с точностью $\pm 1^\circ$. Ориентационные зависимости спектров снимались при вращении магнитного поля H_0 в кристаллографической плоскости $\langle 110 \rangle$ с шагом 5° .

2. Обсуждение результатов

В спектрах обоих образцов в низкотемпературной области (ниже 290 К) можно выделить две резонансные линии разной интенсивности, химического сдвига и ширины (рис. 1), причем каждая обладает собственной зависимостью от ориентации образца в магнитном поле, обусловливающей

общую ориентационную зависимость формы линии и второго момента спектра (рис. 2). Указанные особенности экспериментальных спектров можно объяснить, привязав наблюдаемые компоненты к сигналам фтор-ионов разных структурных позиций. В решетке флюорита имеется одна структурная позиция фтора с тетраэдрической координацией по катионам (F_p). Во флюоритоподобных твердых растворах $M_{1-x}R_xF_{2+x}$ избыточный заряд R^{3+} -катиона компенсируется фтор-ионами междуузельных октаэдрических позиций (F_m). Малоинтенсивная компонента естественно относится к сигналу F_m , тогда как интенсивную отнесем к F_p .

Различие химических сдвигов линий находит объяснение в рамках предлагаемой привязки, поскольку F_p и F_m имеют разное ионное окружение в кристаллической решетке. Отметим, что если в образце 1 линия, относимая к сигналу F_m , сдвинута в слабое поле относительно компо-

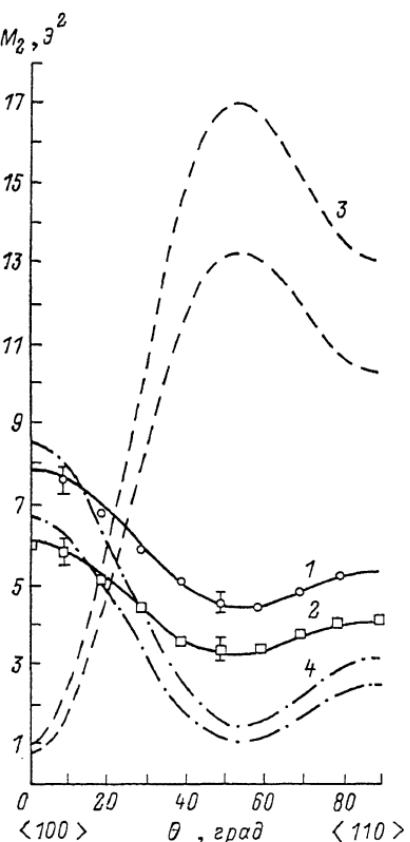


Рис. 2. Экспериментальные зависимости вторых моментов спектров ЯМР ^{19}F образцов $\text{Sr}_{0.75} \cdot \text{La}_{0.25} \text{F}_{2.25}$ (1) и $\text{Ba}_{0.75} \text{Y}_{0.25} \text{F}_{2.25}$ (2) и рассчитанные парциальные вторые моменты для F_m (3) и F_p (4).

ненты F_p на 30 ± 15 м. д., то в спектрах образца 2 эта линия сдвинута на 35 ± 15 м. д., но уже в сильное поле. Величина ошибки обусловлена в значительной мере погрешностью в разбиении спектра на составляющие, а также точностью измерения сдвига. Так как образцы относятся к разным типам флюоритоподобных твердых растворов, можно предположить возможность определения структурного типа твердого раствора по относительным химическим сдвигам ЯМР F_p и F_m .

Химические сдвиги резонанса ядер фтора в диамагнитный фторидах с ионным типом химической связи обусловлены перекрыванием заполненных электронных оболочек ионов [4], поэтому разность химических сдвигов сигналов решеточного и междуузельного ионов фтора $\Delta\delta$ разумно выразить через интегралы перекрывания

$$\Delta\delta = \sum_{n, v, \mu} \mathcal{I}(S_n^{v\mu})|_p - \sum_{n, v, \mu} \mathcal{I}(S_n^{v\mu})|_m. \quad (1)$$

Явный вид функций, определяемых локальной конфигурацией изучаемого иона, приводится в [4]. $S_n^{v\mu}$ — интегралы перекрывания v -орбитали решеточного (междуузельного) фтор-иона с μ -орбиталью n -го со-

седнего иона. Интегралы перекрывания могут быть представлены аналитическим выражением

$$S_n^{\text{up}} = A_{\text{up}} \exp(-r_n/\rho_{\text{up}}), \quad (2)$$

где r_n — межионное расстояние, A_{up} , ρ_{up} — коэффициенты, значения которых приведены в работах [4, 5].

Расчеты химических сдвигов с помощью выражений (1) и (2) требуют структурной информации о локальном окружении фтор-ионов с высокой точностью. К сожалению, для исследуемых образцов таковая отсутствует, поэтому оценки сдвигов разумно провести, предполагая идеализированную структуру твердого раствора, когда F_m находится строго в октаэдрической позиции, а F_p , соседствующие с редкоземельными катионами, не испытывают релаксации. Параметры элементарной ячейки образцов определены из рентгенографических данных и на рентгеновском гониометре и равны 5.841 ± 0.005 и 6.090 ± 0.05 Å соответственно для образцов 1 и 2. Теоретические оценки, полученные для образца 1, дают значение разности сдвигов -21 м. д., которое хорошо согласуется с экспериментом (-30 м. д.). Соответствие для образца 2 хуже, хотя и дает правильный знак разности сдвигов: $+3$ м. д., но заметно отличается по величине от экспериментального значения ($+35$ м. д.). Причина количественного расхождения, по-видимому, в неучете релаксации кристаллической решетки вокруг дефектов, поскольку сдвиги в силу соотношения (2) очень чувствительны к межионным расстояниям.

Наблюдаемая ориентационная зависимость ширин линий отдельных компонент и общего второго момента спектров образцов тоже находит объяснение в предполагаемой привязке спектральных линий к позициям F_p и F_m .

Теоретический второй момент компоненты, соответствующей позиции F_p , имеет максимальное значение для ориентации магнитного поля вдоль кристаллографической оси $\langle 100 \rangle$ и минимальное — вдоль $\langle 111 \rangle$. Для компоненты, соответствующей F_m , противоположная зависимость: максимум — вдоль оси $\langle 111 \rangle$, минимум — $\langle 100 \rangle$. Заметим, что корень квадратный из второго момента является среднеквадратичной шириной линии, поэтому понятно совпадение экстремумов второго момента и наблюдаемой ширины линий компонент (см., например, [6]). С учетом чисел заполнения решеточной n_p и междоузельной позиции n_m расчеты вторых моментов подтверждают экспериментальную ориентационную зависимость общего второго момента спектров (рис. 2).

Во флюоритоподобных твердых растворах $M_{1-x}R_xF_{2+x}$ числа заполнения анионных позиций важны для понимания структурного строения и механизмов ионного транспорта, поскольку переход в суперионное состояние сопровождается увеличением n_m . Площади отдельных компонент в спектре пропорциональны числу резонансных ядер соответствующих позиций, следовательно, ЯМР может использоваться для определения n_p и n_m . К сожалению, спектры изучаемых соединений недостаточно разрешены и трудно с хорошей точностью оценить n_p и n_m по площадям отдельных компонент. В этом случае следует проводить оценку по интегральной характеристике спектра — второму моменту M_2 , который является функцией чисел заполнения позиций и вторых моментов компонент F_p и F_m .

$$M_2 = \frac{2n_p}{(2n_p + n_m)} M_2^p + \frac{n_m}{(2n_p + n_m)} M_2^m,$$

$$M_2^p = n_p M_2(p-p) + n_m M_2(p-m), \quad M_2^m = n_p M_2(m-p) + n_m M_2(m-m). \quad (3)$$

Значения парциальных вторых моментов ($M_2(p-p)$ и др.) рассчитывались по формуле Ван-Флека (см., например, [6]) с учетом всех основных и междоузельных позиций. Анализ сходимости соответствующих решеточных сумм показал, что достаточно учесть соседние ядра фтора в сфере с радиусом, равным трем параметрам элементарной ячейки флюорита.

Вклад катионов во второй момент оказывается пренебрежимо малым. Для сопоставления теоретических и экспериментальных значений второго момента спектра мы использовали величину $R = \sum_i [(M_2^r(\theta_i) - M_2^a(\theta_i)) / M_2^a]^2$, здесь θ_i — угол ориентации внешнего магнитного поля в кристаллографической плоскости [110]. Варьируя числа заполнения n_p и n_m , на ЭВМ отыскивали минимум R . Минимальному значению R отвечает определенное множество n_p и n_m , поэтому для отбора оптимальных значений чисел заполнения мы воспользовались дополнительной связью чисел заполнения позиций с долей примесных катионов в растворе: $n_p = (2-v)/2$, $n_m = (x+v)$, где v — количество вакансий в основных анионных позициях F_p . Мы отобрали те значения n_p и n_m , которым соответствовали расчетные значения x в формуле раствора, наиболее близкие к данным рентгенофлюоресцентного анализа. Полученные значения для образцов 1, 2 соответ-

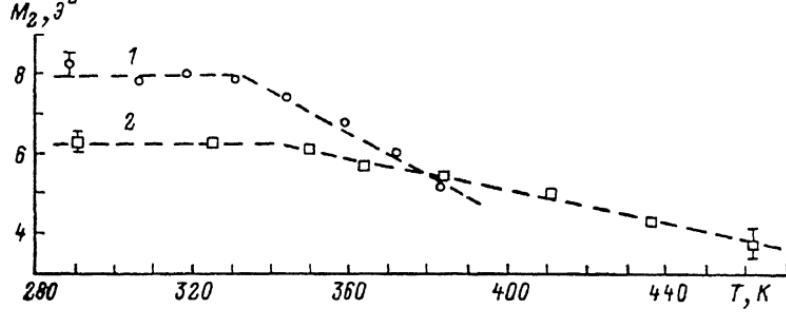


Рис. 3. Температурная зависимость второго момента экспериментальных спектров ЯМР ^{19}F образцов $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ (1) и $\text{Ba}_{0.75}\text{Y}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ (2) при направлении внешнего магнитного поля параллельно кристаллографической оси $\langle 100 \rangle$.

ственno равны $n_p=1.00$ и $n_m=0.20 \pm 0.03$ и 0.18 ± 0.02 . Ошибка обусловлена неточностью измерения второго момента спектра и параметра элементарной ячейки; кроме того, имеется дополнительная неточность, связанная с неучетом релаксации кристаллической решетки при расчете парциальных вторых моментов ($M_2(p-p)$ и др.). Полученные значения чисел заполнения находятся в согласии с наблюдаемыми интенсивностями компонент F_p и F_m спектра (рис. 1).

При нагревании образцов наблюдается трансформация формы спектральных линий, выражаяющаяся в их сужении и появлении узкой компоненты, а также уменьшении второго момента экспериментального спектра (рис. 3). Такое поведение характерно для твердотельных систем с диффузионной подвижностью атомов, если частота их движения превышает ширину резонансной линии жесткой решетки (10^4 Гц). Одновременное существование узкой и широкой компонент, а также затянутость переходной области более чем на 100° (рис. 3) свидетельствуют о динамической неоднородности фторной подсистемы — наличии ионов фтора с разной подвижностью. Динамическую неоднородность разумно связать со структурной неэквивалентностью, наличием F_p и F_m анионов и некоторой неоднородностью внутри этих подсистем.

Химический сдвиг узкой линии чувствителен к типу структурных позиций, которые занимают ионы в процессе диффузии; следовательно, сопоставляя химические сдвиги узких и широких линий, можно определить эти позиции. Если движение идет лишь по позициям одного типа, то химические сдвиги «жесткой» и узкой линий должны совпадать и не зависеть от температуры. В случае, когда ион при миграции посещает и другие структурные позиции, сдвиг узкой линии будет представляться усредненной величиной $\langle \delta \rangle = \sum_k p_k \delta_k$, где p_k , δ_k — весовой коэффициент и химический сдвиг k -ой структурной позиции. В рассматриваемом случае k соответствует F_p и F_m .

Измерения химического сдвига узкой линии, проведенные на $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$ ($290 \text{ K} < T < 420 \text{ K}$), показали, что с повышением температуры сдвиг узкой линии изменяется от величины, близкой к химическому сдвигу F_a , к средней величине сдвигов F_m и F_p . Поскольку условием для наблюдения сигналов подвижных ионов в виде узкой линии является необходимость обладать частотой перескоков больше 10^4 Гц , то ясно, что при низких температурах этот порог преодолевают только самые «быстрые» ионы, а более «медленные» вносят свой вклад в узкую линию при соответствующей более высокой температуре. Следовательно, близость химического сдвига узкой компоненты к сдвигу междуузельных ионов фтора в низкотемпературной области означает, что более подвижными являются междуузельные ионы. Отклонение химического сдвига узкой линии от значения, близкого к сдвигу F_a , при повышении температуры говорит о вкладе в нее ядер ионов другого типа — решеточных.

Таким образом, анализ данных, полученных на $\text{Sr}_{0.75}\text{La}_{0.25}\text{F}_{2.25}$, показывает, что в исследуемом интервале температур ионная проводимость определяется обоими типами ионов (F_p и F_m), причем подвижность ионов в междуузельных позициях больше, чем в решеточных.

В заключение, сопоставляя возможности метода непрерывного ЯМР ^{19}F при исследовании парамагнитных [3] и диамагнитных флюоритоподобных твердых растворов $M_{1-x}R_x\text{F}_{2+x}$, уместно отметить, что в парамагнитных растворах метод более чувствителен к особенностям структуры, а в диамагнитных — к динамике ионов. Поэтому исследования твердых растворов, которые являются структурными и динамическими аналогами, но относятся к разным магнитным типам, могут взаимодополнять друг друга.

Л и т е р а т у р а

- [1] Мурадян Л. А., Максимов Б. А., Симонов В. И. Коорд. химия, 1986, т. 12, № 10, с. 1398—1403.
- [2] Corish J., Catlow C. R. A., Jacobs P. W. M., Ong S. H. Phys. Rev. B, 1982, vol. 25, N 10, p. 6425—6438.
- [3] Мацулев А. Н., Бузник В. М., Лившиц А. И. и др. ФТТ, 1987, т. 29, № 11, с. 3247—3252.
- [4] Бузник В. М. Ядерный магнитный резонанс в ионных кристаллах. Новосибирск: Наука, 1981. 225 с.
- [5] Hafmeister D. W., Flygare W. H. J. Chem. Phys., 1965, vol. 43, N 3, p. 795—799.
- [6] Абрагам А. Ядерный магнетизм. М.: ИЛ, 1963. 551 с.

Институт химии и химической технологии
СО АН СССР
Красноярск

Поступило в Редакцию
6 июня 1988 г.